

シリコンPチャンネルMOS形電界効果トランジスタ

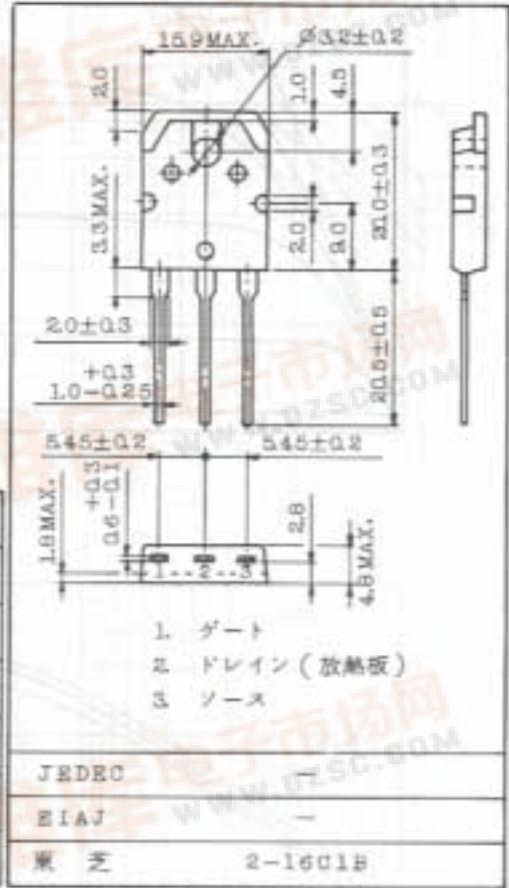
2SJ115

○ 低周波電力増幅用

単位: mm

特長

- 高耐圧です。 : $V_{DSS} = -160V$
- 高順方向伝達アドミタンスです。 : $|Y_{fs}| = 2.0S$ (標準)
- 2SK405 とコンプリメンタリになります。



最大定格 (Ta = 25°C)

項目	記号	定格	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	-160	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	±20	V
ドレイン電流	I_D	-8	A
許容損失 (Tc = 25°C)	P_D	100	W
チャンネル温度	T_{ch}	150	°C
保存温度	T_{atg}	-55 ~ 150	°C

JEDEC	—
EIAJ	—
東芝	2-16C1B

電気的特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{DS} = 0, V_{GS} = \pm 20V$	—	—	±1.0	μA
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = -5mA, V_{GS} = 0$	-160	—	—	V
ゲート・ソース間しゝ断電圧	$V_{GS(OFF)}$ (注)	$V_{DS} = -10V, I_D = -0.1A$	-0.8	—	-2.8	V
ドレイン・ソース間飽和電圧	$V_{DS(ON)}$	$I_D = -5A, V_{GS} = -10V$	—	-3.5	-7.0	V
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS} = -10V, I_D = -2A$	1.0	2.0	—	S
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = -10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	800	—	pF
出力容量	C_{oss}	$V_{DS} = -10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	500	—	pF
母漏容量	C_{rs}	$V_{DS} = -10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	110	—	pF

V_{GS(OFF)}区分 0: -0.8 ~ -1.6, Y: -1.4 ~ -2.8

